

Высокочастотные диоды**Справочная информация о высокочастотных диодах с характеристиками**

- 2Д401А, 2Д401Б, 2Д401В, 2Д419А, 2Д419Б, 2Д419В, 2Д419Г, 2Д419Д, 2Д420А, 2Д422А, 2Д422Б, 2Д423А, 2Д423Б, 2ДС408А1, 2ДС408Б1, 2ДС408В1, 2ДС408Г1, АД425А, АД425Б, ГД402А, ГД402Б, ГД403А, ГД404АР, Днод , КД407А, КД409А, КД409А9, КД409Б, КД409Б9, КД409В, КД410А, КД410Б, КД411АМ, КД411БМ, КД411ВМ, КД411ГМ, КД411ДМ, КД411ЕМ, КД411НМ, КД412А, КД412Б, КД412В, КД412Г, КД413А, КД413Б, КД416А, КД416Б, КД417А, КД421А, КД424А, КД424В, КД424Г, КД427А, КД427Б, КД427В, КД427Г, КД427Д, КДС414А1, КДС414Б1, КДС414В1, КДС415А1, КДС415Б1, КДС415В1

Технические характеристики высокочастотных диодов Д401 - КД427

Диод (цоколевка)	Uоб/Uiмп В/В	Iпр/Iимп мА/мА	Uпр/Iпр В/мА	Cд/Uд пф/В	Iо(25)Iом мкА/мкА	Fmax МГц
2Д401А	75/	30/90	1.0/5	1.0/5	5/100	100
2Д401Б	75/	30/90	1.0/5	1.0/5	5/100	100
2Д401В	100/	30/90	1.2/5	1.0/5	5/100	100
2Д419А	15/	10/	0.15/0.1	1.5/0	10/	400
2Д419Б	30/	10/	0.4/1	1.5/0	10/	400
2Д419В	50/	10/	0.4/1	1.5/0	10/	400
2Д419Г	15/	10/	0.5/1	2/0	10/	400
2Д419Д	10/	10/	0.4/1	1.5/0	10/	400
2Д420А	24/35	50/500	1.0/50	1.0/0	1/	
2Д422А	1.5/	5/	0.35/5		70/	
2Д422Б	1.5/	5/	0.35/5		70/	
2Д423А	1000/2000	/400	3/20		1500/	
2Д423Б	800/1600	/400	3/20		1500/	
2ДС408А1	12/12	10/100	0.83/0.1	1.3/5	0.01/	
2ДС408Б1	12/12	10/100	0.83/0.1	1.3/5	0.01/	
2ДС408В1	12/12	10/100	0.83/0.1	1.3/5	0.01/	
2ДС408Г1	12/12	10/100	0.83/0.1	1.3/5	0.1/	
АД425А	600/600		2/2000		2000	
АД425Б	400/400		2/2000		2000	
ГД402А	15/	30/100	0.45/15	0.8/5	100/	
ГД402Б	15/	30/100	-	0.5/5	100/	
ГД403А	5/	5/				
ГД404АР	3/	20/	0.4/10			
КД407А	24/24	50/500	1.0/50	1.0/5	0.5/10	
КД409А	24/	50/500	1.0/50	2/15	0.5/10	-
КД409А9	40/40	100/500	1.0/50	1.5/20	0.5/10	-
КД409Б	40/	50/500	1.0/50	1.5/20	0.5/10	1000
КД409Б9	40/40	50/500	1.0/50	1.5/15	0.5/10	1000
КД409В	24/	50/500	1.0/50	2/15	0.5/10	1000
КД410А	/1000	50/	2.0/50		3 мА/5 мА	0.02
КД410Б	/600	50/	2.0/50		3 мА/5 мА	0.02
КД411АМ	/700	2А/100А	1.4/1 А		300/700	
КД411БМ	/750	2А/100А	1.4/1 А		300/700	
КД411ВМ	/600	2А/100А	1.4/1 А		300/700	
КД411ГМ	/500	2А/100А	2.0/1 А		300/700	
КД411ДМ	/550	2А/	1.4/1 А		10/	

КД411ЕМ	/300	2А/	1.4/1 А		10/	
КД411НМ	/800	2А/	1.4/1 А		1/	
КД412А	1000/1000	10А/20А	2.0/10 А		100/2000	
КД412Б	800/800	10А/20А	2.0/10 А		100/2000	
КД412В	600/600	10А/20А	2.0/10 А		100/2000	
КД412Г	400/	10А/20А	2.0/10 А		100/	
КД413А	24/	20/20	1.0/20	0.7/0		
КД413Б	24/	20/20	1.0/20	0.7/0		
КД416А	400/400	0.3/15 А	3/15А	25/400	500/	
КД416Б	200/200	0.3/15 А	-	25/400	500/	
КД417А	24/	20/	1/20	0.4/1		
КД421А	5/	0.65/1	0.4/0			
КД424А	250/250	350/2000	1.1/300	10/0	0.1/10	
КД424В	200/200	350/2000	1.1/300	10/0	0.1/10	
КД424Г	150/150	350/2000	1.1/300	10/0	0.1/10	
КД427А	/750	1000/8000	1.4/1000			30
КД427Б	/650	1000/8000	1.4/1000			30
КД427В	/550	1000/8000	1.4/1000			30
КД427Г	/350	1000/8000	1.4/1000			30
КД427Д	/150	1000/8000	1.4/1000			30
КДС414А1	20/30	10/20	0.75/1	3/0	0.01/	
КДС414Б1	20/30	10/20	0.75/1	3/0	-	
КДС414В1	20/30	10/20	0.75/1	3/0	-	
КДС415А1	20/30	10/20	0.75/1	3/0	0.01/	
КДС415Б1	20/30	10/20	0.75/1	3/0	-	
КДС415В1	20/30	10/20	0.75/1	3/0	-	

• **Условные обозначения электрических параметров высокочастотных диодов:**

Обозначение:

Параметр

Uоб/Uимп В/В	максимально допустимое постоянное (Uоб) или импульсное (Uимп) обратное напряжение на диоде.
Iпр/Iимп мА/мА	максимально допустимый постоянный (Iпр) или импульсный (Iимп) прямой ток через диод.
Uпр/Iпр В/мА	максимальное падение напряжения (Uпр) на диоде при заданном прямом токе (Iпр) через него.
Сд/Uд пф/В	емкость диода (Сд) и напряжение на диоде (Uд), при котором она измеряется.
Iо(25)Iом мкА/мкА	обратный ток диода при предельном обратном напряжении. Приводится для температуры +25 (Iо(25)) и максимальной рабочей температуры (Iом).
Fmax МГц	максимальная рабочая частота диода.

* Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.

Значение со звездочкой (*) приводится для импульсного режима.

Параметр, помеченный буквой "т" означают, что приводится типовое значение.

• **Область применения высокочастотных диодов:**

Высокочастотные диоды входят в группу полупроводниковых диодов, которые предназначены для обработки ВЧ сигналов. Существуют 2 разновидности высокочастотных диодов: 1 – детекторные ВЧ диоды, которые выделяют НЧ сигнал из модулированного. 2 – смесительные ВЧ диоды, которые предназначены для перемножения двух ВЧ сигналов.